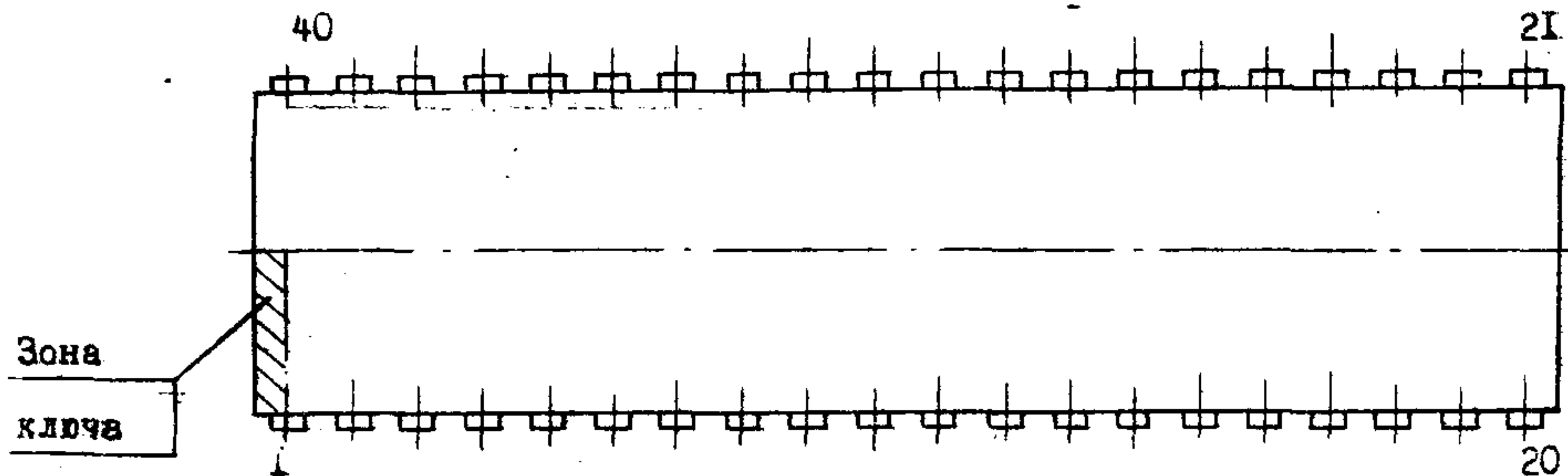




Э Т И К Е Т К А

Микросхема КР1830ВВ48 в пластмассовом корпусе выполнена по полупроводниковой КМОП технологии, предназначена для использования в качестве однокристалльной микро-ЭВМ.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫВОДОВ



Основные электрические параметры в диапазоне температур от минус 10°C до 70°C

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Выходное напряжение высокого уровня сигналов данных (\overline{DB}), В ($I_{OH} = -0,4$ мА)	U_{OH}	2,4	-
Выходное напряжение высокого уровня сигналов \overline{RD} , \overline{WR} , \overline{PME} , \overline{ALE} , В ($I_{OH} = -0,1$ мА)	U_{OH1}		
Выходное напряжение высокого уровня сигналов $P1$, $P2$, \overline{PR} , $T0$, В ($I_{OH2} = -0,04$ мА)	U_{OH2}		
Выходное напряжение низкого уровня сигналов данных (\overline{DB}), В ($I_{OL} = 2,0$ мА)	U_{OL}	-	0,45
Выходное напряжение низкого уровня сигналов \overline{RD} , \overline{WR} , \overline{PME} , \overline{ALE} , В ($I_{OL1} = 1,8$ мА)	U_{OL1}		
Выходное напряжение низкого уровня сигнала \overline{PR} , В ($I_{OL2} = 1,0$ мА)	U_{OL2}		
Выходное напряжение низкого уровня сигналов $P1$, $P2$, $T0$, В ($I_{OL3} = 1,6$ мА)	U_{OL3}		
Ток утечки на входах, мкА	I_{L1}	-10	10
Средний ток потребления в динамическом режиме, мА	I_{CCO}	-	8
Ток потребления (в режиме микропотребления), мкА	I_{CO}		100
Входное напряжение высокого уровня, В	U_{IH}	2,2	5,25
Входное напряжение высокого уровня сигналов $\overline{VQ1}$, \overline{SR} , В	U_{IH1}	3,8	
Входное напряжение низкого уровня, В	U_{IL}	-0,5	0,8

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт изделий

Золото - *2,5259г*

Серебро -

Цветных металлов не содержит

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхема КР1830ВЕ48 соответствует техническим условиям ОК0.348.954-01 ТУ.

ЛК 98